

研究評価委員会

「低炭素社会を実現する超低電圧ナノエレクトロニクスプロジェクト/
ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発」
(事後評価) 分科会

日 時：平成24年9月21日(金曜日) 12:30~17:55

場 所：大手町サンスカイルーム(朝日生命大手町ビル27階) A室

議事次第

<公開の部>

1. 開会、分科会の設置、資料の確認 12:30~12:40 (10分)
2. 分科会の公開について 12:40~12:45 (5分)
3. 評価の実施方法と評価報告書の構成について 12:45~12:55 (10分)
4. プロジェクトの概要説明 12:55~13:40 (説明25分、質疑20分)
 - 4-1 事業の位置付け・必要性 および研究開発マネジメント 12:55~13:05 (10分)
 - 4-2 研究開発成果、実用化の見通し 13:05~13:20 (15分)
 - 4-3 質疑 13:20~13:40 (20分)

(休憩 10分) 13:40~13:50(10分)

非公開資料の取扱いについて 13:50~13:55(5分)

<非公開の部>

5. プロジェクトの詳細説明【入替】 (13:55~17:35)
※以下、各テーマ20分(説明10分/質疑10分)×9テーマ、入替2分
 - 5-①-1) シリコンナノワイヤトランジスタの知識統合研究開発
 - 5-①-2) ナノワイヤFETの研究開発
 - 5-①-3) シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究と集積化の研究開発
 - 5-②-1) 新構造FinFETによるSRAM技術の研究開発
 - 5-②-2) 次世代相変化メモリ技術の研究開発
 - 5-②-3) ナノギャップ不揮発メモリ技術の研究開発

(休憩 20分) 16:07~16:27(20分)

- 5-③-1) カーボンナノチューブトランジスタ技術の研究開発
- 5-③-2) シリコンプラットフォーム上III-V族半導体チャネルトランジスタ技術の研究開発
- 5-③-3) シリコンウェハ中の原子空孔濃度定量評価技術の研究開発

(一般傍聴者入室) (2分)

<公開の部>

- | | |
|--------------|-------------------|
| 6. まとめ・講評 | 17:35～17:50 (15分) |
| 7. 今後の予定、その他 | 17:50～17:55 (5分) |
| 8. 閉会 | |

以上